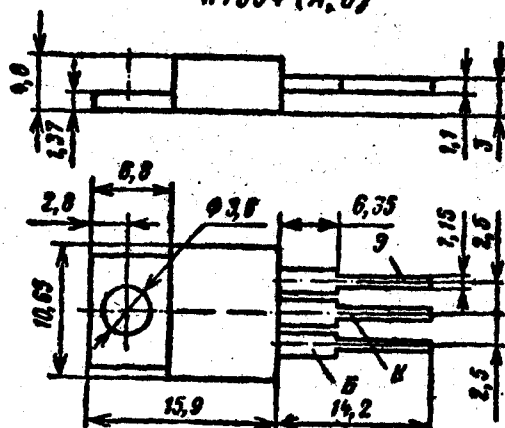


КТ854 (А, Б)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в преобразователях, линейных стабилизаторах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами

Масса транзистора не более 2,5 г.

КТ854 (А, Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=4$ В, $I_Э=2$ А, не менее	20
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_Э=0,5$ А, не менее	10 МГц
Граничное напряжение при $I_Э=0,1$ А, $L=160$ мГн, не менее:	
КТ854А	350 В
КТ854Б	200 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_К=5$ А, $I_Э=1$ А, не более	2 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ}=U_{КБ, макс}$, не более	3 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=5$ В, не более	5 мА

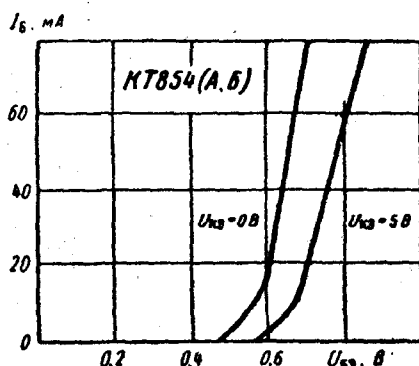
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:	
КТ854А	600 В
КТ854Б	400 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сэ} \leq 10$ Ом:	
КТ854А	500 В
КТ854Б	300 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	5 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора	15 А
Постоянный ток базы	3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_К = -40^\circ \text{C} \dots +25^\circ \text{C}$	60 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	$+150^\circ \text{C}$
Температура окружающей среды	$-40^\circ \text{C} \dots T_К = +100^\circ \text{C}$

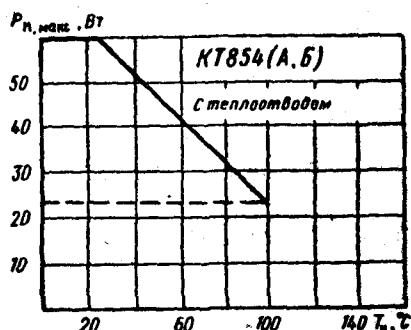
При монтаже допускается одnorазовый изгиб выводов транзистора не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° с радиусом закругления не менее 2,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более $+260^\circ \text{C}$ в течение не более 3 с. При пайке корпус паяльника должен быть заземлен. Разрешается осуществлять пайку путем погружения выводов в расплавленный припой с температурой не более $+250^\circ \text{C}$ в течение не более 5 с. Допускается пайка волной припоя с температурой не более $+240^\circ \text{C}$.

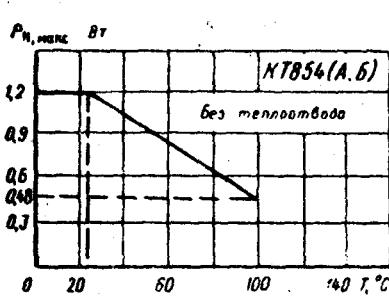
Допустимое значение статического потенциала 1000 В.



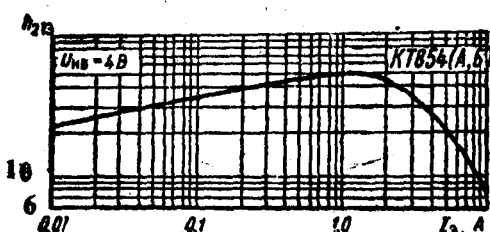
Входные характеристики



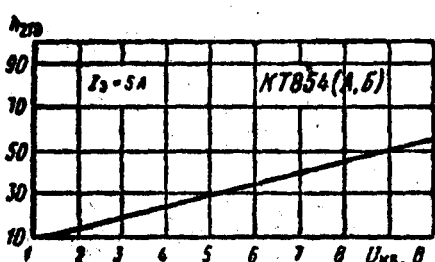
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



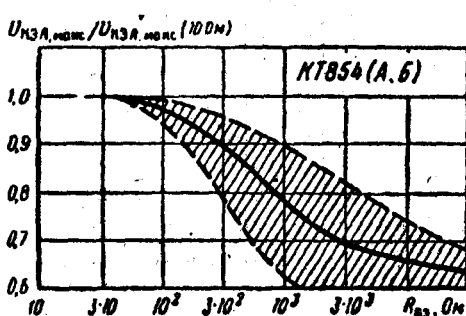
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры



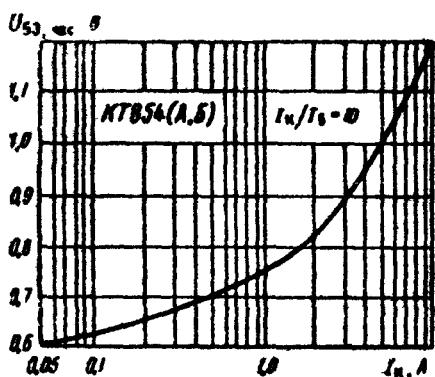
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



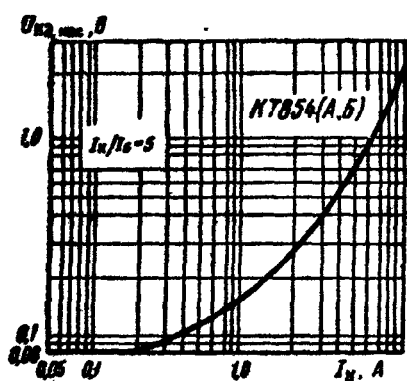
Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор — база



Зона возможных положений зависимости максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер

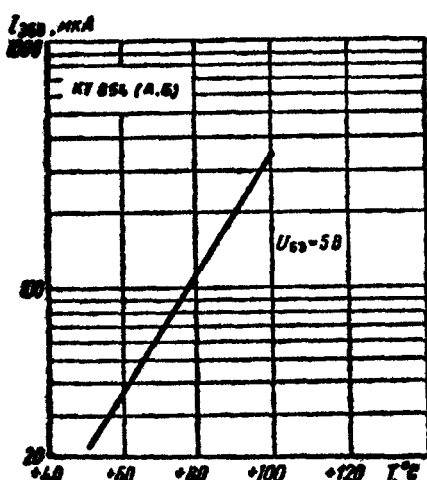


Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора

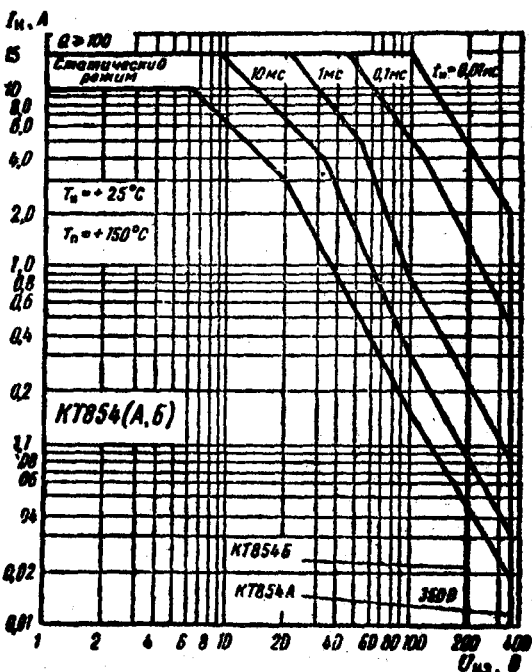


Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора

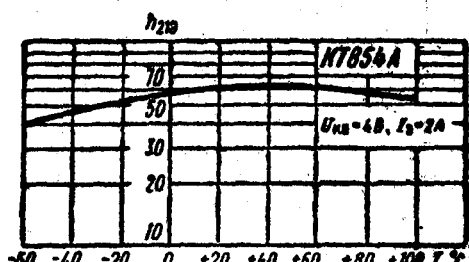
Зависимость обратного тока коллектора от температуры



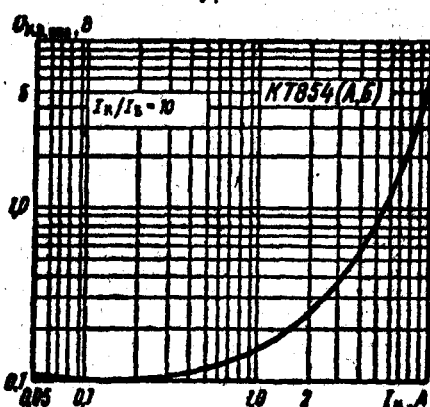
Зависимость обратного тока эмиттера от температуры



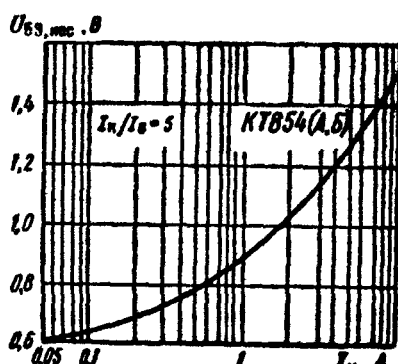
Области максимальных режимов



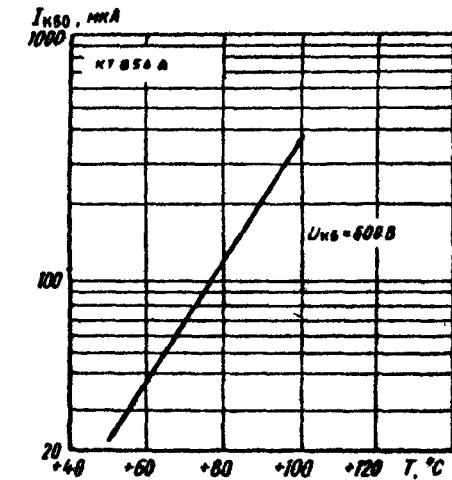
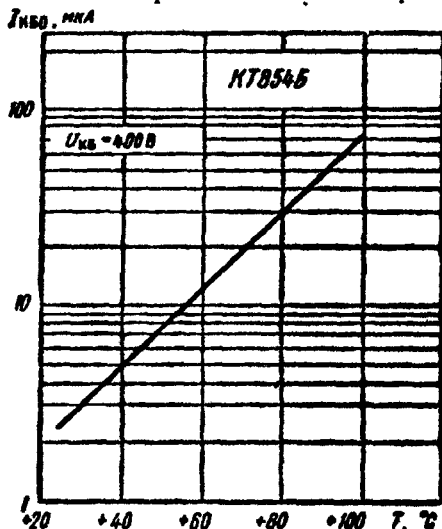
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



Зависимость обратного тока коллектора от температуры